

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Направление подготовки/специальность: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Наименование образовательной программы: Вычислительно-измерительные системы

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Очная

Рабочая программа дисциплины
ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА

Блок:	Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Часть образовательной программы:	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
№ дисциплины по учебному плану:	Б1.Ч.07.03.02
Трудоемкость в зачетных единицах:	5 семестр - 3;
Часов (всего) по учебному плану:	108 часов
Лекции	5 семестр - 32 часа;
Практические занятия	не предусмотрено учебным планом
Лабораторные работы	5 семестр - 16 часов;
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
Самостоятельная работа	5 семестр - 59,7 часа;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	проводится в рамках часов аудиторных занятий
включая: Дискуссия Контрольная работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет с оценкой	5 семестр - 0,3 часа;

Москва 2025

ПРОГРАММУ СОСТАВИЛ:

Преподаватель

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Поляхов М.Ю.
	Идентификатор	Rc6ffb528-PoliakhovMY-309b8b47

М.Ю. Поляхов

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
образовательной
программы

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Хвостов А.А.
	Идентификатор	Rd7c1e2e7-KhvostovAA-a55ec66d

А.А. Хвостов

Заведующий выпускающей
кафедрой

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Самокрутов А.А.
	Идентификатор	R145b9cc2-SamokrutovAA-7b5e7df

А.А.
Самокрутов

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины: изучение основ построения электронных схем и узлов электронных устройств.

Задачи дисциплины

- изучение основ построения электронных схем;
- изучение различных типов электронных устройств;
- формирование первичных навыков монтажа электронных схем и их проверки;
- формирование навыков проведения экспериментальных исследований электронных устройств и ознакомление с принципами проведения этих исследований;
- формирование навыков работы с аппаратурой, используемой при наладке и испытаниях узлов электронных устройств.

Формируемые у обучающегося **компетенции** и запланированные **результаты обучения** по дисциплине, соотнесенные с **индикаторами достижения компетенций**:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения
ПК-1 Способен обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности	ИД-3 _{ПК-1} Производит оценку влияния применяемых технических решений на общее функционирование системы	знать: - основные свойства и особенности схем на операционных усилителях; - основные свойства транзисторных усилителей, основные правила макетирования электрических схем и принципов их отладки. уметь: - производить анализ работы транзисторных усилителей; - пользоваться современными средствами измерения и контроля, обосновывать выбор таких средств для решения конкретных задач, обрабатывать и представлять экспериментальные данные.
РПК-3 Способен анализировать состояние средств измерений в организации, внедрение в процессы производства необходимых средств измерений и стандартных образцов и методик измерений	ИД-2 _{РПК-3} Проводит калибровочные процедуры измерительных систем	знать: - основные свойства элементов с одним р-п переходом и схем на их основе, основные правила оформления технической документации. уметь: - производить расчет практических схем с диодами и стабилитронами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО

Дисциплина относится к основной профессиональной образовательной программе Вычислительно-измерительные системы (далее – ОПОП), направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, уровень образования: высшее образование - бакалавриат.

Требования к входным знаниям и умениям:

- знать теоретические основы электротехники
- знать математический аппарат. Тригонометрические функции, способы вычисления интегралов и производных
- уметь производить расчет линейных электрических схем

Результаты обучения, полученные при освоении дисциплины, необходимы при выполнении выпускной квалификационной работы.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

№ п/п	Разделы/темы дисциплины/формы промежуточной аттестации	Всего часов на раздел	Семестр	Распределение трудоемкости раздела (в часах) по видам учебной работы										Содержание самостоятельной работы/ методические указания	
				Контактная работа							СР				
				Лек	Лаб	Пр	Консультация		ИКР		ПА	Работа в семестре	Подготовка к аттестации /контроль		
КПР	ГК	ИККП	ТК												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Полупроводниковые диоды	21	5	6	4	-	-	-	-	-	-	11	-	<p><u>Подготовка к лабораторной работе:</u> Для выполнения заданий по лабораторной работе необходимо предварительно изучить тему и задачи выполнения лабораторной работы, а так же изучить вопросы вариантов обработки результатов по изученному в разделе "Полупроводниковые диоды" материалу. Выполнить подготовку к лабораторной работе, сделать заготовку отчета.</p> <p><u>Подготовка к контрольной работе:</u> Изучение материалов по разделу Полупроводниковые диоды и подготовка к контрольной работе</p> <p><u>Изучение материалов литературных источников:</u></p> <p>[2], стр.18-50 [3], стр.46-90 [5], стр.4-6 [6], стр.15-35</p>	
1.1	Полупроводниковые диоды	21		6	4	-	-	-	-	-	-	11	-		
2	Транзисторы и их основные применения	34.7		10	4	-	-	-	-	-	-	-	20.7		-
2.1	Биполярные транзисторы и их основные применения	23		8	4	-	-	-	-	-	-	-	11		-
2.2	Полевые транзисторы	11.7		2	-	-	-	-	-	-	-	-	9.7		-

													подготовку к лабораторной работе, сделать заготовку отчета. <u>Подготовка к контрольной работе:</u> Изучение материалов по разделу Транзисторы и их основные применения и подготовка к контрольной работе <u>Изучение материалов литературных источников:</u> [1], стр.120-147 [2], стр. 52-194, 196-303 [3], стр.91-108, 120-135 [5], стр.7-10
3	Обратные связи в усилителях	21	4	3	-	-	-	-	-	-	14	-	<u>Подготовка к лабораторной работе:</u> Для выполнения заданий по лабораторной работе необходимо предварительно изучить тему и задачи выполнения лабораторной работы, а так же изучить вопросы вариантов обработки результатов по изученному в разделе "Обратные связи в усилителях" материалу. Выполнить подготовку к лабораторной работе, сделать заготовку отчета. <u>Изучение материалов литературных источников:</u> [3], стр.226-238 [4], стр.505-549 [5], стр.11-13
3.1	Обратные связи в усилителях	21	4	3	-	-	-	-	-	-	14	-	<u>Подготовка к лабораторной работе:</u> Для выполнения заданий по лабораторной работе необходимо предварительно изучить тему и задачи выполнения лабораторной работы, а так же изучить вопросы вариантов обработки результатов по изученному в разделе "Усилители постоянного тока" материалу. Выполнить подготовку к лабораторной работе, сделать заготовку отчета. <u>Изучение материалов литературных источников:</u> [3], стр.226-238 [4], стр.505-549 [5], стр.11-13
4	Усилители постоянного тока	31	12	5	-	-	-	-	-	-	14	-	<u>Подготовка к лабораторной работе:</u> Для выполнения заданий по лабораторной работе необходимо предварительно изучить тему и задачи выполнения лабораторной работы, а так же изучить вопросы вариантов обработки результатов по изученному в разделе "Усилители постоянного тока" материалу. Выполнить подготовку к лабораторной работе, сделать заготовку отчета. <u>Изучение материалов литературных источников:</u> [3], стр.226-238 [4], стр.505-549 [5], стр.11-13
4.1	Усилители постоянного тока	31	12	5	-	-	-	-	-	-	14	-	<u>Подготовка к лабораторной работе:</u> Для выполнения заданий по лабораторной работе необходимо предварительно изучить тему и задачи выполнения лабораторной работы, а так же изучить вопросы вариантов обработки результатов по изученному в разделе "Усилители постоянного тока" материалу. Выполнить подготовку к лабораторной работе, сделать заготовку отчета. <u>Изучение материалов литературных источников:</u> [3], стр.226-238 [4], стр.505-549 [5], стр.11-13

														[2], стр. 358-433, 541-622 [3], стр.347-391 [5], стр.14-17
	Зачет с оценкой	0.3		-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	
	Всего за семестр	108.0		32	16	-	-	-	-	-	0.3	59.7	-	
	Итого за семестр	108.0		32	16	-	-	-	-	-	0.3	59.7	-	

Примечание: Лек – лекции; Лаб – лабораторные работы; Пр – практические занятия; КПр – аудиторные консультации по курсовым проектам/работам; ИККП – индивидуальные консультации по курсовым проектам/работам; ГК- групповые консультации по разделам дисциплины; СР – самостоятельная работа студента; ИКР – иная контактная работа; ТК – текущий контроль; ПА – промежуточная аттестация

3.2 Краткое содержание разделов

1. Полупроводниковые диоды

1.1. Полупроводниковые диоды

Вольтамперная характеристика идеального р-п - перехода. ВАХ реального полупроводникового диода. Характеристики, схемы замещения и параметры диодов. Выпрямительные и специальные диоды. Выпрямители, формирователи и ограничители напряжения. Полупроводниковые стабилитроны. Характеристики, параметры и схемы замещения. Применение стабилитронов. Тиристоры, динисторы, симисторы..

2. Транзисторы и их основные применения

2.1. Биполярные транзисторы и их основные применения

Принцип действия биполярного (БП) транзистора. Классификация и основные применения БП транзисторов. Три схемы включения БП транзистора. Режимы большого и малого сигналов. Схемы замещения БП транзисторов. Усилительный каскад на БП транзисторе. Графический и графоаналитический методы расчета усилителей на БПТ. Физические и h - параметры БП транзисторов. Характеристики и параметры каскада на переменном токе. Схемы включения транзисторов в усилитель. Температурная стабильность по постоянному току. Схемы замещения каскада по переменному току. Частотные характеристики и площадь усиления. Широкополосные каскады усиления..

2.2. Полевые транзисторы

Принцип действия, характеристики и параметры полевых транзисторов. Полевые транзисторы с р-п - переходом. Транзисторы с изолированным затвором (МОП-транзисторы). Усилительные каскады на полевых транзисторах. Схемы замещения и особенности применения..

3. Обратные связи в усилителях

3.1. Обратные связи в усилителях

Классификация обратных связей в усилителях. Влияние обратной связи на характеристики усилителей. Устойчивость усилителей с обратной связью..

4. Усилители постоянного тока

4.1. Усилители постоянного тока

Интегральные усилители постоянного тока или интегральные операционные усилители постоянного тока (УГО, свойства). Применение операционных усилителей. Инвертирующий усилитель. Неинвертирующий усилитель. Дифференциальный усилитель. Суммирующе-инвертирующий. Суммирующе-неинвертирующий усилитель. Усилитель суммирующее-вычитающий. Интегрирующий усилитель. Дифференцирующий усилитель. Фазовращатель. Логарифмический усилитель. Антилогарифмический усилитель. Возведение в степень и извлечение корня. Статические параметры реального операционного усилителя. Схема замещения реального операционного усилителя. Расчет погрешностей для инвертирующего усилителя. Мультипликативные составляющие погрешности. Аддитивные составляющие погрешности. Способы компенсации напряжения смещения. Практическая схема балансировки нуля. Влияние изменения источника питания. Расчет погрешности для интегратора. Вариант подключения балансировки нуля для неинвертирующего усилителя. Динамические параметры реального операционного усилителя. Цепи частотной коррекции, построение ЛАЧХ частотно скомпенсированного ОУ..

3.3. Темы практических занятий

не предусмотрено

3.4. Темы лабораторных работ

1. Исследование схем на операционных усилителях;
2. Исследование влияния обратных связей на свойства усилителей;
3. Исследование однокаскадных усилителей на биполярных транзисторах;
4. Полупроводниковые элементы с одним р-п переходом и неуправляемые выпрямители.

3.5 Консультации

Групповые консультации по разделам дисциплины (ГК)

1. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Полупроводниковые диоды"
2. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Транзисторы и их основные применения"
3. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Обратные связи в усилителях"
4. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Усилители постоянного тока"

Текущий контроль (ТК)

1. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Полупроводниковые диоды"
2. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Транзисторы и их основные применения"
3. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Обратные связи в усилителях"
4. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Усилители постоянного тока"

3.6 Тематика курсовых проектов/курсовых работ

Курсовой проект/ работа не предусмотрены

3.7. Соответствие разделов дисциплины и формируемых в них компетенций

Запланированные результаты обучения по дисциплине (в соответствии с разделом 1)	Коды индикаторов	Номер раздела дисциплины (в соответствии с п.3.1)				Оценочное средство (тип и наименование)
		1	2	3	4	
Знать:						
основные свойства транзисторных усилителей, основные правила макетирования электрических схем и принципов их отладки	ИД-3ПК-1		+			Дискуссия/Исследование однокаскадных усилителей на биполярных транзисторах
основные свойства и особенности схем на операционных усилителях	ИД-3ПК-1			+		Дискуссия/Исследование схем на операционных усилителях
основные свойства элементов с одним р-п переходом и схем на их основе, основные правила оформления технической документации	ИД-2РПК-3	+				Дискуссия/Полупроводниковые элементы с одним р-п переходом и неуправляемые выпрямители
Уметь:						
пользоваться современными средствами измерения и контроля, обосновывать выбор таких средств для решения конкретных задач, обрабатывать и представлять экспериментальные данные	ИД-3ПК-1				+	Дискуссия/Исследование влияния обратных связей на свойства усилителей Дискуссия/Исследование схем на операционных усилителях
производить анализ работы транзисторных усилителей	ИД-3ПК-1		+			Дискуссия/Исследование однокаскадных усилителей на биполярных транзисторах Контрольная работа/Расчет транзисторных усилителей
производить расчет практических схем с диодами и стабилитронами	ИД-2РПК-3	+				Дискуссия/Полупроводниковые элементы с одним р-п переходом и неуправляемые выпрямители Контрольная работа/Расчет электрических схем с полупроводниковыми элементами с одним р-п переходом

4. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ)

4.1. Текущий контроль успеваемости

5 семестр

Форма реализации: Защита задания

1. Исследование влияния обратных связей на свойства усилителей (Дискуссия)
2. Исследование однокаскадных усилителей на биполярных транзисторах (Дискуссия)
3. Исследование схем на операционных усилителях (Дискуссия)
4. Полупроводниковые элементы с одним р-п переходом и неуправляемые выпрямители (Дискуссия)

Форма реализации: Письменная работа

1. Расчет транзисторных усилителей (Контрольная работа)
2. Расчет электрических схем с полупроводниковыми элементами с одним р-п переходом (Контрольная работа)

Балльно-рейтинговая структура дисциплины является приложением А.

4.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

Зачет с оценкой (Семестр №5)

В соответствии с текущими правилами БАРС

В диплом выставляется оценка за 5 семестр.

Примечание: Оценочные материалы по дисциплине приведены в фонде оценочных материалов ОПОП.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Печатные и электронные издания:

1. Электротехника и электроника. В 3 кн. Кн.3. Электрические измерения и основы электроники : Учебник для подготовки в вузах бакалавров и инженеров неэлектротехнических направлений и специальностей / Г. П. Гаев, и др. ; Ред. В. Г. Герасимов. – М. : Энергоатомиздат, 1998. – 432 с. – ISBN 5-283-05007-6 : 26.00.;
2. Гусев, В. Г. Электроника : Учебное пособие для приборостроительных специальностей вузов / В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1991. – 622 с. – ISBN 5-06-000681-6.;
3. Хоровиц, П. Искусство схемотехники : пер. с англ. / П. Хоровиц, У. Хилл. – 5-е изд., перераб. – М. : Мир, 1998. – 704 с. – ISBN 5-03-003315-7 : 84.00.;
4. Титце, У. Полупроводниковая схемотехника. Т. 1 : пер. с нем. / У. Титце, К. Шенк. – 12-е изд. – М. : ДМК Пресс, 2015. – 828 с. – ISBN 978-5-97060-136-5.;
5. Поляхов, М. Ю. Основы электронной техники. Лабораторные работы № 1-4 : по курсу "Электроника и микропроцессорная техника" по направлению "Приборостроение" / М. Ю. Поляхов, А. А. Хвостов, А. С. Крюков, Нац. исслед. ун-т "МЭИ" (НИУ"МЭИ"). – М. : Изд-во МЭИ, 2018. – 18 с.
[http://elib.mpei.ru/elib/view.php?id=10313;](http://elib.mpei.ru/elib/view.php?id=10313)

6. А. А. Титов- "Транзисторные усилители мощности МВ и ДМВ", Издательство: "СОЛОН-ПРЕСС", Москва, 2009 - (326 с.)
[https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117742.](https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117742)

5.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

1. Office / Российский пакет офисных программ;
2. Windows / Операционная система семейства Linux.

5.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:

1. ЭБС Лань - <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
3. Научная электронная библиотека - <https://elibrary.ru/>
4. База данных Web of Science - <http://webofscience.com/>
5. База данных Scopus - <http://www.scopus.com>
6. Национальная электронная библиотека - <https://rusneb.ru/>
7. Электронная библиотека МЭИ (ЭБ МЭИ) - <http://elib.mpei.ru/login.php>
8. Портал открытых данных Российской Федерации - <https://data.gov.ru>
9. Электронная открытая база данных "Polpred.com Обзор СМИ" - <https://www.polpred.com>
10. Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» - <https://openedu.ru>
11. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии - <http://protect.gost.ru/>
12. Открытая университетская информационная система «РОССИЯ» - <https://uisrussia.msu.ru>

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тип помещения	Номер аудитории, наименование	Оснащение
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий и текущего контроля	С-201, Учебная аудитория	парта со скамьей, стол преподавателя, стул, доска меловая
	Ж-120, Машинный зал ИВЦ	сервер, кондиционер
Учебные аудитории для проведения практических занятий, КР и КП	Е-501, Лаборатория осветительных приборов и прототипирования каф. "Светотехники"	стол преподавателя, стол, стул, доска маркерная
	Ж-120, Машинный зал ИВЦ	сервер, кондиционер
Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий	Е-519, Лаборатория спектральных и колориметрических измерений каф. "Светотехники"	стол преподавателя, стул, компьютер персональный
	Ж-120, Машинный зал ИВЦ	сервер, кондиционер
Учебные аудитории для проведения промежуточной аттестации	Е-501, Лаборатория осветительных приборов и прототипирования каф. "Светотехники"	стол преподавателя, стол, стул, доска маркерная
Помещения для самостоятельной работы	НТБ-303, Лекционная аудитория	стол компьютерный, стул, стол письменный, вешалка для одежды,

		компьютерная сеть с выходом в Интернет, компьютер персональный, принтер, кондиционер
Помещения для консультирования	Е-402, Кабинет сотрудников "ВМСС"	
Помещения для хранения оборудования и учебного инвентаря	Е-403, Склад	стол для работы с документами, шкаф, шкаф для документов, книги, учебники, пособия, дипломные и курсовые работы студентов

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Электроника и микропроцессорная техника

(название дисциплины)

5 семестр

Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине:

- КМ-1 Полупроводниковые элементы с одним р-n переходом и неуправляемые выпрямители (Дискуссия)
- КМ-2 Расчет электрических схем с полупроводниковыми элементами с одним р-n переходом (Контрольная работа)
- КМ-3 Исследование однокаскадных усилителей на биполярных транзисторах (Дискуссия)
- КМ-4 Расчет транзисторных усилителей (Контрольная работа)
- КМ-5 Исследование влияния обратных связей на свойства усилителей (Дискуссия)
- КМ-6 Исследование схем на операционных усилителях (Дискуссия)

Вид промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

Номер раздела	Раздел дисциплины	Индекс КМ:	КМ-1	КМ-2	КМ-3	КМ-4	КМ-5	КМ-6
		Неделя КМ:	4	8	10	12	14	16
1	Полупроводниковые диоды							
1.1	Полупроводниковые диоды		+	+				
2	Транзисторы и их основные применения							
2.1	Биполярные транзисторы и их основные применения				+	+		
2.2	Полевые транзисторы				+			
3	Обратные связи в усилителях							
3.1	Обратные связи в усилителях							+
4	Усилители постоянного тока							
4.1	Усилители постоянного тока						+	+
Вес КМ, %:			15	20	20	10	15	20